



1N5802US/1N5804US/1N5806US

Superfast Recovery Diodes

Surface Mount (US)

POWER DISCRETES

Description

Quick reference data

V_R 50 -150 V

I_F 1N5802US to 1N5806US = 2.5A

t_{rr} 1N5802US to 1N5806US = 25nS

I_R 1N5802US to 1N5806US = 1μA

Features

- ◆ Very low reverse recovery time
- ◆ Hermetically sealed non-cavity construction
- ◆ Soft, non-snap, off recovery characteristics
- ◆ Very low forward voltage drop

These products are qualified to MIL-PRF-19500/477 and are preferred parts as listed in MIL-HDBK-5961. They can be supplied fully released as JANTX, JANTXV and JANS versions.

Electrical Specifications

Electrical specifications @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified.

	Symbol	1N5802US	1N5804US	1N5806US	Units
Working Reverse Voltage	V_{RWM}	50	100	150	V
Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	50	100	150	V
Average Forward Current (@ 75°C lead length = 0.375')	$I_{F(AV)}$	2.5			A
Repetitive Surge Current (@ 55°C lead length = 0.375')	I_{FRM}	14			A
Non-Repetitive Surge Current ($t_p = 8.3\text{ms}$ @ V_r & T_{JMAX})	I_{FSM}	35			A
Storage Temperature Range	T_{STG}	-65 to +175			$^\circ\text{C}$
Average Forward Current Max (pcb mounted: $T_A = 55^\circ\text{C}$) Sine wave Square wave ($d = 0.5$)	$I_{F(AV)}$ $I_{F(AV)}$	1.0 1.1			A
P_t for fusing ($t = 8.3\text{ms}$) max	P_t	10			A^2S
Forward Voltage Drop max @ $T_J = 25^\circ\text{C}$	V_F	0.875 @ 1A			V
Reverse Current max @ V_{WRM} , $T_J = 25^\circ\text{C}$ @ V_{WRM} , $T_J = 100^\circ\text{C}$	I_R I_R	1.0 50			μA
Reverse Recovery Time max (1.0A I_F to 1.0A I_{RM} recover to 0.25A $I_{RM(REC)}$)	t_{rr}	25			nS
Junction Capacitance typ @ $V_R = 5\text{V}$ $f = 1\text{MHz}$	C_J	25			pF
Thermal Resistance to end cap	$R_{\theta JEC}$	13			$^\circ\text{C/W}$

POWER DISCRETES

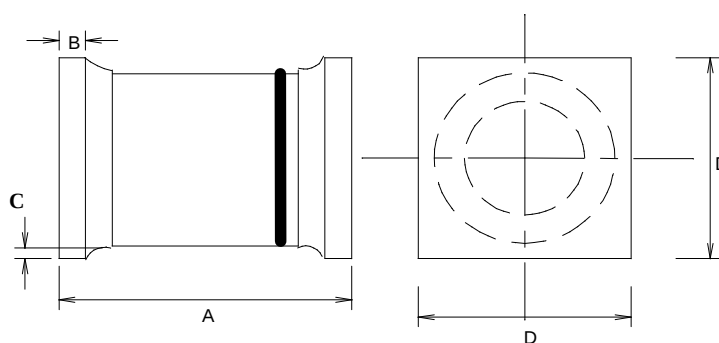
Ordering Information

Part Number	Description
1N5802US, 1N5804US, 1N5806US	Surface Mount ⁽¹⁾

Note:

(1) Available in trays and tape and reel packaging. Please consult factory for quantities.

Outline Drawing



*Cathode is denoted by a black band on a white body.

	Dimensions in Inches	
	1N5802US - 1N5806US	
	MIN	MAX
A	0.168	0.2
B	0.019	0.028
C	0.003	-
D	0.091	0.103

Contact Information

Semtech Corporation
Power Discretes Products Division
200 Flynn Road, Camarillo, CA 93012
Phone: (805)498-2111 FAX (805)498-3804

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9